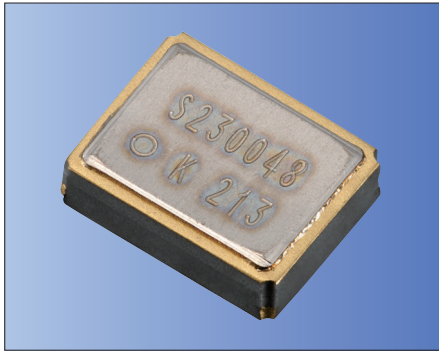


表面贴装型数码温度补偿晶体振荡器 KT3225T系列

CMOS/ 3.0V Typ. / 3.2×2.5mm



AEC-Q200

RoHS指令对应产品

■特点

- 小型表面贴装类型(3.2×2.5×1.0mm)
- 32.768kHz数码温度补偿振荡器(DTCXO)
- 高精度频率温度特性: $\pm 5.0 \times 10^{-6}/-40 \sim +85^{\circ}\text{C}$
- 低电流消耗: 1.5 μA Typ ($V_{\text{DD}} = 3.0\text{V}$, 无负载时输出)
- 温度补偿工作电源电压: 2.0V~5.5V
- 工作温度: $-40 \sim +105^{\circ}\text{C}$ (可选)

■用途

- 高精度时间参照
- 通用MCU(内置RTC功能)

■型号表示方法

- 频率稳定度(vs温度): $\pm 3.8 \times 10^{-6}/-10^{\circ}\text{C} \sim 60^{\circ}\text{C}$

KT3225T 32768 D G R □ □ T xx
① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧

- 频率稳定度(vs温度): $\pm 5.0 \times 10^{-6}/-40^{\circ}\text{C} \sim 85^{\circ}\text{C}$

KT3225T 32768 E A W □ □ T xx
① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧

①系列名称

②输出频率

③频率温度特性

④下限保证温度

⑤上限保证温度

	③	④	⑤
DGR	$\pm 3.8 \times 10^{-6}$	-10°C	$+60^{\circ}\text{C}$
EAW	$\pm 5.0 \times 10^{-6}$	-40°C	$+85^{\circ}\text{C}$

⑥电源电压

⑦初始频率偏差

	⑥	⑦
30	3.0V	T $\pm 3.0 \times 10^{-6}$
33	3.3V	
50	5.0V	

⑧个别规格

包装方式(载带包装 3000个/ 卷盘)

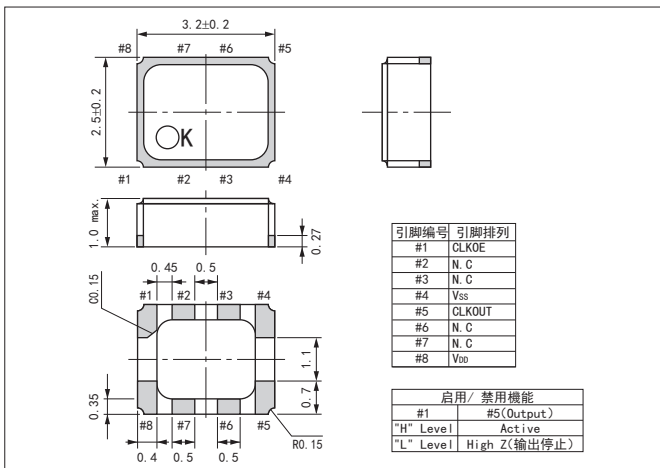
■规格

项 目	记 号	条 件/ 备 注	规 格			单 位
			Min.	Typ.	Max.	
公称频率	f _{nom}		—	32.768	—	kHz
电源电压	振荡输出	V _{DD}	1.3	3.0	5.5	V
	温度补偿	V _{TEM}	2.0	3.0	5.5	V
存储温度范围	T _{stg}		-40	+25	+85	$^{\circ}\text{C}$
工作温度范围	T _{use}		-40	+25	+85	$^{\circ}\text{C}$
初始频率偏差	—	Ta=25 $\pm 2^{\circ}\text{C}$	-3.0	—	+3.0	$\times 10^{-6}$
频率温度特性	f _o -T _c	E: Ta=-40~+85 $^{\circ}\text{C}$	-5.0	—	+5.0	$\times 10^{-6}$
频率电源电压特性	df/fo	V _{DD} = 2.0~5.5V, Ta=25 $\pm 2^{\circ}\text{C}$	-1.0	—	+1.0	$\times 10^{-6}/\text{V}$
频率长期变化	f _{age}		-3.0	—	+3.0	$\times 10^{-6}$
L电平输出电压	V _{OL}	I _{OL} = +1.0mA, V _{DD} = 3V	0.0	—	0.8	V
H电平输出电压	V _{OH}	I _{OH} = -1.0mA, V _{DD} = 3V	2.2	—	3.0	V
L电平输入电压	V _{IL}	CLKOE端子	0.0	—	0.2×V _{DD}	V
H电平输入电压	V _{IH}	CLKOE端子	0.8×V _{DD}	—	5.5	V
占空比	Duty	负载: 15pF	40	—	60	%
上升时间	Tr	20% V _{DD} →80% V _{DD} , 负载: 15pF, V _{DD} =3V	—	—	100	ns
下降时间	Tf	80% V _{DD} →20% V _{DD} , 负载: 15pF, V _{DD} =3V	—	—	100	ns
振荡启动时间	t _{str}	Ta=25 $^{\circ}\text{C}$	—	—	1.0	sec
		Ta=-40~+85 $^{\circ}\text{C}$	—	—	3.0	sec
电流消耗1	I _{cc1}	CLKOE=V _{SS} , V _{DD} =3V	—	0.6	2.0	μA
电流消耗2	I _{cc2}	CLKOE=V _{DD} , V _{DD} =3V, 无负载时输出	—	1.5	4.0	μA
		CLKOE=V _{DD} , V _{DD} =3V, 负载: 15pF	—	2.7	5.5	μA
输出负载条件	L _{CMOS}	CMOS Output	—	—	15.0	pF

* 以上规格为标准品规格, 如需其他规格, 敬请咨询。

■外形尺寸

(单位: mm)



■推荐焊盘图案

(单位: mm)

